08

# Влияние на зарядообразование электрических полей на поверхностях наноструктурированных электродов

#### © А.П. Кузьменко, А.Е. Кузько, Д.И. Тимаков

Юго-Западный государственный университет, 305040 Курск, Россия e-mail: apk3527@mail.ru

#### (Поступило в Редакцию 17 февраля 2012 г.)

По результатам обработки ACM-изображений специально созданных наноструктурированных электродов из разных металлов показано, что профиль вершин наноструктур с высокой степенью достоверности аппроксимируется параболическими зависимостями. По полученным данным для наноструктурированной поверхности электродов на основании зависимости Фаулера-Нордгейма рассчитываются локальная напряженность электрического поля и инжекционные токи, проведен качественный анализ и показана применимость развиваемого подхода для построения электроконвекционных массо- и теплообменных устройств.

### Введение

Для повышения эффективности управления электроконвективным тепло- и массообменном в химических производствах, космической технике, немеханических переключателях наибольший практический интерес представляет локальное усиление внешнего электрического поля на нано- и микроструктурах [1,2]. Нано- и микроструктурированные металлические поверхности удается сформировать путем механической полировки на алмазных пастах с размерами зерна до 20 nm с химическим травлением [3]. Как показал анализ полученных при этих условиях образцов, на их поверхностях формируются самоорганизованные структуры.

В электрических полях наличие на поверхностях электродов нано- и микроструктур вызывает размерные эффекты туннелирования и низкополевой эмиссии электронов [4–7]. Диссоциационно-рекомбинационные процессы в межэлектродном промежутке, заполненном жидким диэлектриком, приводят к его расслоению на диссоциационно-рекомбинационный —  $\xi_d$  и диффузионный —  $\xi_D$  слои с толщинами вплоть до десятков nm и µm соответственно. Диффузионный слой в свою очередь состоит из двух подслоев: адсорбционного и диффузного, которые также существенно влияют на конфигурацию и параметры локальных электрических полей вблизи электродов [8]. Электроконвекционные явления по своей природе имеют нестационарный и нелинейный характер, что наряду с многофазностью системы "металлические электроды-диэлектрическая жидкость" еще более усложняет их описание. Аналитический анализ в такой ситуации весьма затруднен, так как требует совместного решения электрогидродинамических уравнений. Полученное решение должно описывать процессы превращений электрической энергии в механическую энергию жидкости, что и определяет эффективность тепло- и массообмена. Для численного моделирования

таких процессов, как правило, используются задания конфигурации электродов, свойств жидкости и других параметров [9].

В настоящей работе предлагается использовать наноструктурированные системы металлических электродов с поверхностями из регулярных и упорядоченных структур наномасштабных размеров для повышения уровня инжекции зарядов, инициирования режима развитой электроконвекции. Показано, что построенные атомносиловые микроскопические (АСМ) профили наноструктурированных поверхностей таких электродов могут применяться для описания инжекционных функций, по которым предлагается моделирование электроконвекционных явлений.

# 1. Результаты анализа поверхностей электродов

Для изучения влияния состояния и структурных особенностей поверхности электродов на электроконвекционные процессы был разработан теплообменник специальной конструкции. Поверхности электродов, приготовленные по методике, изложенной в [3], были исследованы методами атомно-силовой и растровой электронной микроскопии. Изображения поверхностей, полученные этими методами, показали наличие идентичных особенностей в виде развитой структуры, в которой отмечается формообразование самоорганизованных наноструктурированных объектов. Для описания формы возникающих при обработке структур из всех изученных металлических образцов из титана, меди, вольфрама и манганина [3] были отобраны образцы из меди и вольфрама, как обладающие наиболее развитой наноструктурированной поверхностью.

Анализ и обработка полученных атомно-силовых микроскопических АСМ-изображений проводились с помощью программного обеспечения типа Gwyddion 2.9, специализирующегося именно на визуализации и обработке данных сканирующей зондовой микроскопии.

Типичный фрагмент профиля и объемного АСМизображения, полученного с поверхности меди с характерными особенностями, представлен на рис. 1. Форма каждого отдельного структурного элемента на медной поверхности может быть описана параболоидом вращения, что подтверждается ее профилем в экранной системе координат (рис. 2, *a*), который с достоверностью  $R^2 = 0.95$  действительно может быть аппроксимирован параболой (рис. 2, b). Некоторый общий наклон анализируемого АСМ-изображения структурного элемента обусловлен особенностями сканирования. Точки на профиле выбираются путем кусочно-линейной аппроксимации его исходной формы. Координаты в условных единицах экрана (c.d.u.) и их действительные значения взаимно переводятся: условная экранная единица по оси абсцисс соответствует 50 nm, а по оси ординат 2 nm на АСМизображении соответственно.

Профили для вольфрама образованы самоподобными структурами (рис. 3, *a*). Для поверхности этих образцов характерно образование кластеров, составленных из нескольких простых наноструктур, как это видно из рис. 3, *b*. Огибающая каждой наноструктуры, входящей в кластер, может аппроксимироваться параболой с достоверностью  $R^2 = 0.99$  (рис. 3, *b*-*d*). Таким образом, при анализе поверхностей электродов из меди и вольфрама оправданным приближением по профилям структур рассмотренных электродов является параболоид вращения, что согласуется с выводами [4,5].

Анализировалась структура поверхности медного электрода, подвергнутого химическому травлению в кислотном растворе. Возникающая при этом структура



**Рис. 1.** Типичное объемное АСМ-изображение и фрагмент профиля поверхности меди: *а* — объемный вид поверхности, *b* — фрагмент профиля.



**Рис. 2.** Анализ характерных профилей: *а* — профиль отдельной структуры меди, *b* — аппроксимация профиля параболой.

характеризовалась еще более развитой поверхностью. Размеры отдельных наноструктурных образований, как видно из ACM-изображений поверхности, составили около 240 nm (рис. 4, a, b). Форма типичных одиночных структур может аппроксимироваться с достоверностью 0.97 параболическим профилем (рис. 4, c, d).

Результаты проведенного анализа по всем исследованным металлическим образцам электродов представлены в табл. 1. По измеренным данным, в соответствии с [2], были определены аспектные отношения и плотности возникших структур, расчетные величины которых использовались для установления возможных сценариев зарядообразований как определяющего электроконвекционного механизма.





**Рис. 3.** Типичное объемное АСМ-изображение и фрагмент профиля поверхности вольфрама: *a* — объемный вид поверхности, *b* — фрагмент профиля, *c* — профиль отдельной типичной структуры, *d* — аппроксимация профиля параболой.

**Рис. 4.** Медь после травления: *а* — объемный вид поверхности, *b* — профиль вырезки, *c* — профиль отдельной типичной структуры, *d* — аппроксимация профиля параболой.

Материал электродов	Средняя высота, (( <i>h</i> )), nm	Средний размер (( <i>d</i> )), nm	Аспектное отношение $(\langle h \rangle / \langle d \rangle)$	Плотность структур $(\rho = N/S),$ $\times 10^{8} \text{ cm}^{-2}$
Медь	26	12.4	2.1	69
Медь (травленая)	280	35	8.0	9.5
Вольфрам	230	58	3.9	9.4

Таблица 1. Размеры наноструктурных образований и расчетные величины их аспектного отношения и плотности

## 2. Анализ зарядообразования

Повышение локальной напряженности на зарядообразующих центрах в виде обнаруженных наноструктур вплоть до нескольких десятков kV/cm может сопровождаться сильной нелинейной зависимостью плотности тока и, как следствие, достижением режима развитой электроконвекции. Представленные в [3] мгновенные фотографии демонстрируют протекание электроконвекционных явлений на примере модельных мелкомасштабных электродов, из вида которых становится очевидным рост напряженности.

Процесс электроконвекции с катод-анодными электродами, обладающими развитой поверхностью, будет существенно определяться коэффициентом пропорциональности или форм-фактором  $\beta$  (сm<sup>-1</sup>):

$$\beta = E/U,$$

где U — напряжение между анодом и катодом (V), E — напряженность на вершине структуры (V/cm). Его величина зависит от формы и размеров системы анод-катод и указывает на локальное усиление электрического поля на каждой отдельной наноструктуре:

$$\beta' = \frac{2}{r\ln(2H/r)},\tag{2}$$

где H — расстояние между эмитирующей частью, r — радиус закругления вершины наноструктуры. Радиус закругления вершины можно найти из АСМ-изображений, типа представленных на рис. 1, *a*, 3, *a*, 4, *a*. С учетом перевода масштабов по осям абсцисс и ординат можно построить обобщенное аппроксимирующее уравнение параболического профиля наноструктурных образований в естественной системе координат ( $x_e$ ;  $y_e$ ) (рис. 5):

$$y_e = a(C_y/C_x)x_e^2 + b(C_y/C_x)x_e + c(C_y/C_x),$$
 (3)

где  $C_x$  и  $C_y$  — соответственно коэффициенты перевода по осям абсцисс и ординат из экранной (в с.d.u.) в реальную (в nm); *а, b* и *с* — коэффициенты квадратного уравнения. С учетом геометрических построений (рис. 5) радиус кривизны вершины изучаемой наноструктуры согласно [10]:

$$r = \frac{[1 + y'_e(x_{e0})^2]^{3/2}}{|y''_e(x_{e0})|},$$
(4)

где  $x_{e0} = C_x(-b/2a)$  — координата вершины наноструктуры в естественной системе координат,  $x_0 = (-b/2a)$  — координата вершины структуры в экранной системе координат,  $y'_e$  и  $y''_e$  — первая и вторая производные выражения от обобщенного квадратного уравнения (3) по переменной  $x_e$ . Для профиля в параболической аппроксимации:

$$r = \frac{\left[1 + \left(C_y(2ax_{e0}/C_x + b)/C_x^2\right)\right]^{3/2}}{(2C_y|a/C_x|)^2}.$$
 (5)

Так, например, для типичного профиля отдельной структуры травленой меди (рис. 4, *a*, *b*) с аппроксимирующим уравнением в экранной системе координат вида:  $y = -5.054x^2 + 8.503x - 0.081$ , с a = -5.054,  $x_0 = 0.841$  с.d.u. Коэффициенты перевода составят  $C_x = 333.3$  nm/c.d.u.,  $C_y = 67.2$  nm/c.d.u. Расчетное значение радиуса кривизны вершины наноструктуры составило 163.5 nm. Аналогичным образом получаем расчетные значения радиусов для профилей полированных меди (рис. 1) и вольфрама (рис. 3, *a*, *b*). Рассчитанные величины радиусов кривизны вершин наноструктур для этих металлов составили 289 и 14.8 nm соответственно (таб. 2).

Значения форм-фактора (2) и локальной напряженности при вершине наноструктуры ( $E = \beta'U$ ), к примеру для расстояния между вершиной катода и плоским анодом (рис. 5)  $H = 25 \,\mu$ m и напряжения в системе анодкатод U = 500 V, приведены в табл 2. Для таких величин напряженности, согласно [6], возможна автоэлектронная эмиссия (АЭЭ) с вершин наноструктур. В случае профиля непараболического вида для подобного расчета радиуса кривизны вершины наноструктуры требуется аппроксимация полиномом более высокого порядка.

Для проверки возможности АЭЭ в электродной наноструктурированной системе проведем оценки полного тока эмиссии J<sub>0</sub>, согласно зависимости Фаулера-



Рис. 5. К определению радиуса кривизны вершины наноструктуры.

Таблица 2.	Значения	форм-факто	ра, локальной	напряженно-
сти и плотно	сти тока п	ри вершине	наноструктурн	Ы

Образцы	r, nm	$\beta'$ , cm <sup>-1</sup>	$E, 10^7  \text{V/cm}$	j, A/cm <sup>2</sup>
Медь	289	14000	0.70	$\begin{array}{c}9.3\cdot 10^{-10}\\6.7\cdot 10^{4}\\1.1\cdot 10^{6}\end{array}$
Медь травленая	163.5	22200	1.11	
Вольфрам	14.8	171100	8.55	

Нордгейма [6,7], со всей площади ( $\sigma$ ) отдельной наноструктуры

$$J_0 = j\sigma = \frac{1.54 \cdot 10^{-6} \sigma E_l^2}{\varphi t^2(y)} \exp(-6.83 \cdot 10^7 \varphi^{3/2} f(y)/E_l),$$
(6)

где  $E_l$  — локальная напряженность электрического поля на вершине наноструктуры. Функцию t(y) без больших погрешностей можно принять равной единице, а функция Нордгейма f(y) (при y < 1) определяется  $f(y) = 0.95 - 1.03y^2$ . Переменная y для напряженности в единицах порядка  $10^7$  принимается равной  $y = \delta \varphi / \varphi = 3.8 (E_l)^{1/2} / \varphi$ .

Расчетные величины плотности токов на типичных наноструктурах, рассматриваемых поверхностей металлов, с учетом известных значений работы выхода  $\varphi$  для поликристаллических образцов Cu, W и значений у представлены в табл. 2. В соответствии с выводами [5,6] анализ рассчитанных величин указывает на то, что процесс интенсивного зарядообразования на наноструктурированных поверхностях возможен на электродах, изготовленных из вольфрама и травленой в кислотном растворе меди, тогда как на полированной меди величина *j* оказывается явно недостаточной.

Учтем величину локального усиления электрического поля на вершине катода [1]:  $E_l = \beta E_0 = \beta U/H = \beta'U$ .  $E_0$  — средняя напряженность электрического поля в межэлектродном промежутке анод-катод. При плотности одинаковых N структур, равномерно распространенных по площади наноструктурированной поверхности S:  $\rho = N/S$ . Плотность тока с поверхности электрода в виде наноструктуры определится с учетом (6) как  $j' = J_0\rho$ , а сила тока, которая может быть опытно измерена, будет равна J = j'S.

Величина коэффициента усиления электрического поля (1) для однотипных наноструктур, согласно [2,3], существенно определяется аспектным отношением h/d, где h — высота наноструктуры, d — ее средний размер:  $\beta = h/d + h/H$ . Здесь учтено также H — расстояние между электродами. Размеры h и d определяются из АСМ-изображений наноструктурированных поверхностей. Анализ полученных таким образом по АСМ-изображениям величин  $\beta$  и  $\rho$  показывает, что возможна эффективная инжекция с наноструктурированного катода, изготовленного из вольфрама и травленой меди, тогда как полированная медь может выступать только в качестве анода.

Проведем качественный анализ особенностей применения наноструктурированных электродов в реальных тепло- или массообменных устройствах. Для возникновения электроконвекционных явлений и работы таких устройств в межэлектродный промежуток вводится диэлектрическая жидкость, которая существенно изменяет картину зарядообразования, усложняя ее. Очевидно, что диэлектрическая проницаемость жидкости (є) снижает в є раз как полную напряженность электрического поля, так и значения локальных напряженностей — Е. При анализе зарядообразования на границах раздела сред "металл-диэлектрическая жидкость" следует учесть влияние двойного электрического слоя (ДЭС) толщиной порядка 0.1 nm, в котором под действием электрического поля формируются структурнонеоднородные адсорбционные слои, возникают размерные явления [4,5]. В объеме жидкого диэлектрика протекают диссоциационно-рекомбинацинные процессы [7]. В приэлектродной области выделяются адсорбционный слой толщиной  $\xi_d$  и диффузионный слой толщиной  $\xi_D$ . Толщины каждого слоя  $\xi_D$ ,  $\xi_d$  сильно зависят от напряженности внешнего поля. Так, для практически значимого электрического поля  $E_V$  порядка 1 kV/cm толщина диффузионного слоя  $\xi_D$  не превышает 10 nm, что в несколько раз меньше средних размеров наноструктурных образований на поверхностях электродов (табл. 1).

Локальная напряженность поля E<sub>l</sub> вблизи вершины наноструктуры будет зависеть не только от ее геометрических размеров, но и от напряженности поля  $E_V$ на внешней части диффузионного слоя. Полный коэффициент усиления  $\beta_{\Sigma}$  должен зависеть как от усиления в диффузионном слое  $\beta_D$ , так и от локального усиления, обусловленного геометрией наноструктур  $\beta_l$ . Значение  $\beta_{\Sigma}$  по аналогии с электротехническим цепями возрастает на величину произведения:  $\beta_{\Sigma} = \beta_l \beta_D$ . По характерным размерам, форме вершины и аспектным отношениям элементов нано- структурированной электродной системы (табл. 1) рассчитываются  $\beta_l = h/d + h/H$  $(\beta_l = \beta)$ . Основные сложности связаны с определением  $\beta_D$ . Величина  $\beta_D$  определяется диссоциационнорекомбинационными процессами в жидком диэлектрике, в адсорбционных слоях на наноструктурированых поверхностях электродов, работой выхода электронов [7,8]. Оценка толщины ДЭС  $\xi_D$  в электрическом поле может быть проведена из:  $\xi_D = \varphi_0/E_V$ . Здесь  $\varphi_0 = k_{\rm B}T/e$  специфический осмотический потенциал, величина которого при комнатной температуре для типичной диэлектрической жидкости составляет 0.026 V/cm, k<sub>B</sub> постоянная Больцмана, Т — абсолютная температура, e — заряд электрона,  $E_V$  — электрическая напряженность поля на внешней части ДЭС. Очевидно, что с ростом E<sub>V</sub> толщина ДЭС будет уменьшаться и может оказаться сопоставимой с размерами специально созданных наноструктур (десятки nm), что может способствовать проявлению размерно-резонансных эффектов, на основе которых вполне достижимы режимы развитой электроконвекции и повышение ее эффективности.

# Заключение

Показано, что форма реальных наноструктурированных образований на поверхностях электродов, получаемых путем механической и химической полировки, исследованная методом атомно-силовой микроскопии, может быть аппроксимирована параболоидом вращения. Полученные на этой основе оценки коэффициентов усиления локальных электрических параметров (напряженности и инжекционного тока) подтверждают возможность использования поверхностнонаноструктурированных электродов для достижения режима развитой электроконвекции и построения на этой основе тепло- и массообменных устройств.

Работа выполнена в рамках реализации ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" на 2009–2013 гг. (ГК П913, П547).

## Список литературы

- [1] Белецкий М.Д., Бочаров Г.С., Елецкий А.В., Sommerer T.J. // ЖТФ. 2010. Т. 80. Вып. 2. С. 130–137.
- [2] Елецкий А.В. // УФН. 2010. Т. 180, № 2. С. 897–930.
- [3] Абакумов П.В., Жакин А.И., Кузьменко А.П., Кузько А.Е., Тимаков Д.И. // Известия Юго-Западного государственного университета. 2011. № 1(34). С. 38–44.
- [4] Стеценко Б.В. // ЖТФ. 2011. Т. 81. Вып. 4. С. 152–154.
- [5] Stetsenko B.V., A.I. Shchurenko // Problems of Atomic Sci. and Techn. 2009. N 1. Plasma Physics. P. 136–138.
- [6] Месяц Г.А. // УФН. 1995. Т. 165. № 6. С. 601-626.
- [7] Оура К., Лифшиц В.Г., Саранин А.А., Зотов А.В., Катаяма М. Введение в физику поверхности. М.: Наука, 2006. 490 с.
- [8] Жакин А.И. // УФН. 2006. Т. 176. № 3. С. 281-310.
- [9] Стишков Ю.К., Елагин И.А. // ЖТФ. 2005. Т. 75. Вып. 9. С. 15–19.
- [10] Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. М.: Наука, 1964. 872 с.